

2SC938

NPN エピタキシャル形シリコントランジスタ / NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

低周波増幅用 / Audio Frequency Amplifier

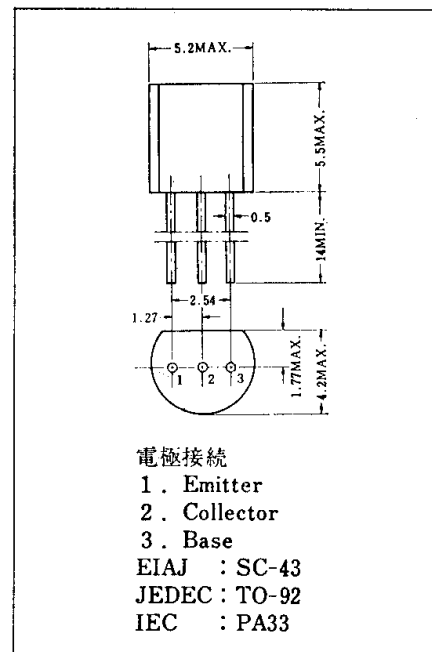
外形図 / PACKAGE DIMENSIONS
(Unit:mm)

特 徴 / FEATURE

・高耐圧です。

High voltage. $V_{CE0} = 60V$ 絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	60	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5.0	V
コレクタ電流	I_C	200	mA
全損失	P_T	250	mW
ジャンクション温度	T_J	125	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +125	$^\circ C$

電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 60V, I_E = 0$			0.1	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 3.0V, I_C = 0$			0.1	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = 1.0V, I_C = 50mA^*$	50	80	232	
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE} = 2.0V, I_C = 150mA^*$	30	70		
直流ベース電圧	V_{BE}	$V_{CE} = 10V, I_C = 10mA$	0.60	0.65	0.90	V
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 150mA, I_B = 15mA^*$		0.15	0.50	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 150mA, I_B = 15mA^*$		0.83	1.20	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = 10V, I_E = -10mA$		150		MHz

* パルス測定 / Pulsed

 h_{FE} 区分 / h_{FE} Classification h_{FE1} / M : 50~94 L : 80~150 K : 125~232